

Промышленные решения



PCIe M.2 SSDs

MTE662P

Твердотельные накопители Transcend MTE662P в форм-факторе M.2 оснащены интерфейсом PCI Express (PCIe) Gen 3 x4 и поддерживают стандарт NVMe Express (NVMe) 1.3, что позволяет им демонстрировать непревзойденный уровень производительности. Твердотельные накопители Transcend MTE662P созданы на базе передовой технологии 3D NAND, позволяющей формировать до 96 слоев флэш-памяти. По сравнению с накопителями, построенными на базе 3D NAND, которые могут иметь только до 64 слоев, новые устройства отличаются более высокой плотностью записи, а встроенный кэш DRAM обеспечивает более быстрый доступ к хранимым данным. Твердотельные накопители MTE662P изготовлены с использованием технологии угловой заливки и имеют контакты, покрытые золотым напылением толщиной 30 мкм. Накопители проходят тщательное заводское тестирование, выдерживают до трех тысяч циклов записи/стирания и способны работать в расширенном диапазоне рабочих температур от -20°C до 75°C. Также накопители поддерживают технологию Intelligent Power Shield (IPS), повышая таким образом общий уровень надежности передачи данных при использовании в критически важных системах.

Характеристики Оборудования

- золотое напыление толщиной 30 мкм
- Встроенный кэш DDR4 DRAM
- Гарантированная работоспособность в расширенном температурном диапазоне (от -20°C до +75°C)
- Встроенная активная система Advanced Power Shield предотвращает потерю данных в случае внезапного отключения питания
- Основные компоненты изделия усилены угловой заливкой

Характеристики Прошивки

- Продвинутый алгоритм глобального выравнивания износа и управления блоками для большей надежности
- Поддержка NVMe команд
- Встроенная функция исправления ошибок (LDPC ECC)
- Динамический термальный троттлинг
- Технология SLC-кэширования

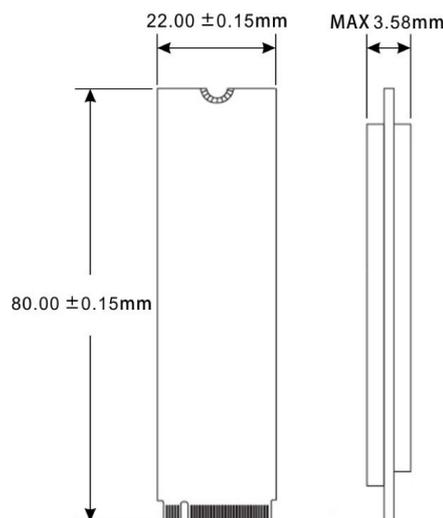
Информация о заказе

256GB TS256GMTE662P

Характеристики

Внешний вид	Размеры	80 mm x 22 mm x 3.58 mm (3.15" x 0.87" x 0.14")
	Вес	9 g (0.32 oz)
	Форм-фактор	M.2
	M.2	2280-D2-M (Двухсторонний)
Интерфейс	Интерфейс шины	NVMe PCIe Gen3 x4
Хранилище	Тип Flash памяти	Память типа 3D
	Емкость	256 ГБ
Рабочая обстановка	Рабочее напряжение	3.3В±5%
	Рабочая температура	расширенный диапазон рабочих -20°C (-4°F) ~ 75°C (167°F)
	Температура хранения	-55°C (-67°F) ~ 85°C (185°F)
	Влажность	5% ~ 95%
	Удар	1500 G, 0.5 ms, 3 оси
	Вибрация (рабочая)	20 G (двойная амплитуда), 7 Hz ~ 2000 Hz (частота)
Питание	Потребляемая мощность (рабочая)	3.3 ватт
	Потребляемая мощность (IDLE)	1.0 ватт
Производительность	Последовательное чтение/запись (CrystalDiskMark, макс.)	Чтение: До 3,200 МБ/с Запись: До 1,300 МБ/с
	4К Произвольное чтение/запись (IOmeter, макс.)	Чтение: До 190,000 IOPS Запись: До 320,000 IOPS
	Среднее время наработки на отказ (MTBF)	3,000,000 час (ов)
	Запись в терабайтах (макс.)	550 TBW
	Ресурс перезаписи в день (DWPD)	2 (3 года)
Гарантия	Сертификат	CE / FCC / BSMI
	Гарантия	Трехлетняя Ограниченная Гарантия

Механические размеры



Характеристики товара могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленные изображения могут отличаться от реальных. Общая доступная емкость варьируется в зависимости от операционной среды. Из-за сложности и разнообразия промышленных приложений Transcend не может гарантировать полную совместимость со всеми платформами в различных аспектах деятельности. Для применения в специальных приложениях и в уникальных условиях, настоятельно рекомендуется заранее связаться с Transcend для получения разъяснений.